

# 革新デバイスを支える III-V 族半導体の成長技術

微細構造トランジスタ、半導体レーザ、太陽電池などに革新をもたらしてきた III-V 族半導体の成長技術、特に自己組織化成長、新機能、集積について基礎の振り返りから最近の報告まで次世代のデバイス研究開発のヒントにすることを狙いとしています。

皆様のご参加をお待ちしております。

## 招待講演者とテーマ（敬称略、五十音順）

荒川泰彦（東京大学）

量子ドットレーザ

伊藤智徳（三重大学）

2次元、3次元成長を分けるメカニズム

北田貴弘（徳島大学）

面発光型 THz デバイス, 副格子交換

杉山正和（東京大学）

超格子の結晶成長技術と太陽電池応用

斗内政吉（大阪大学）

InP 系 THz 帯デバイス

富岡克広（北海道大学）

MOVPE 選択成長法によるナノワイヤ成長とデバイス応用

松尾慎治（NTT）

埋め込みヘテロ成長、フォトニック結晶レーザ

村山明宏（北海道大学）

量子ドットにおけるスピンドイナミクス

山口浩一（電気通信大学）

自己形成量子ドットの成長

応用物理学会  
秋季学術講演会  
シンポジウム

日時

2017 年  
9月8日（金）  
9:00-15:00

場所

福岡国際会議場

一般からの講演も受け付けています。

世話人

荒井昌和

（宮崎大学）

石川史太郎

（愛媛大学）

影山健生

（東京大学/QDレーザ）